

MPSA13 (3DG13) 硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN DARLINGTON TRANSISTOR

用途:适用于要求极高电流增益的设备。

Purpose: Applications requiring extremely high current gain device designed.

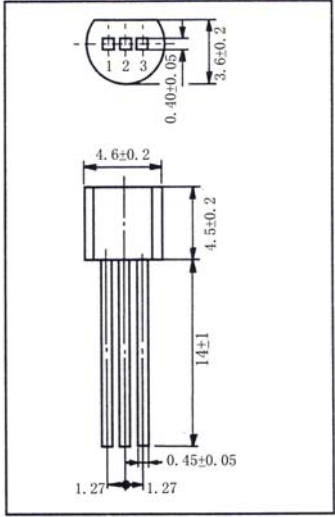
特点:电流增益高。

Features: High current gain.

极限参数/Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	30	V
V_{CE0}	30	V
V_{EB0}	10	V
I_C	500	mA
P_C	625	mW
T_j	150	℃
T_{stg}	-55~150	℃

T0-92 单位:mm



引脚: 1. E 2. B 3. C

电性能参数/Electrical Characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CE0}	$I_C=100\mu A$	$I_B=0$	30			V
I_{CB0}	$V_{CB}=30V$	$I_E=0$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=10V$	$I_C=0$			0.1	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$	$I_C=10mA$	5000			
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$	$I_C=100mA$	10000			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=100mA$	$I_B=0.1mA$			1.5	V
V_{BE}	$V_{CE}=5.0V$	$I_C=100mA$			2.0	V
f_T	$V_{CE}=10V$	$I_C=10mA$	$f=100MHz$	125		MHz